

Figura 1. Esempio di realizzazione di un inverter in tecnologia CMOS.

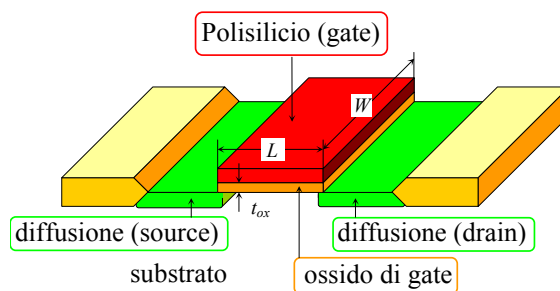


Figura 2. Geometrie che, assieme alle caratteristiche dei materiali utilizzati, definiscono il comportamento del transistore MOS.

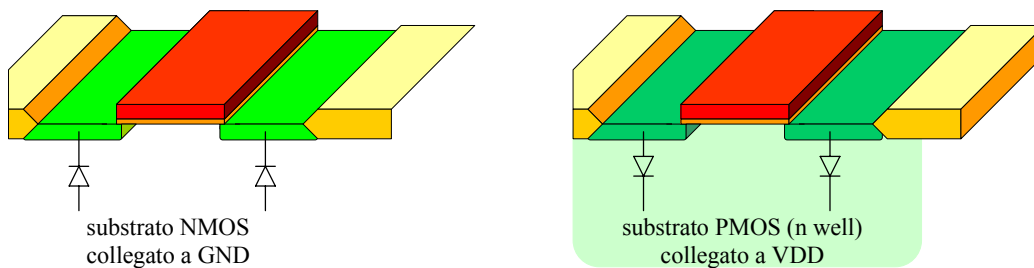


Figura 5. Collegamento del substrato.

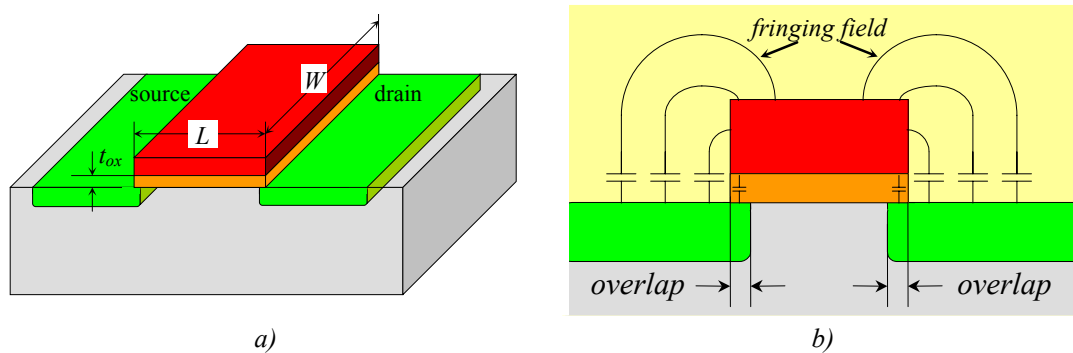


Figura 12. a) Dimensioni per il calcolo della capacità di gate; b) capacità di overlap e di fringing.

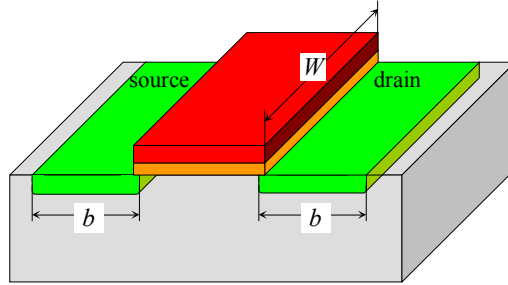


Figura 13. Dimensioni per il calcolo delle capacità di source e di drain (esempio su un NMOS).

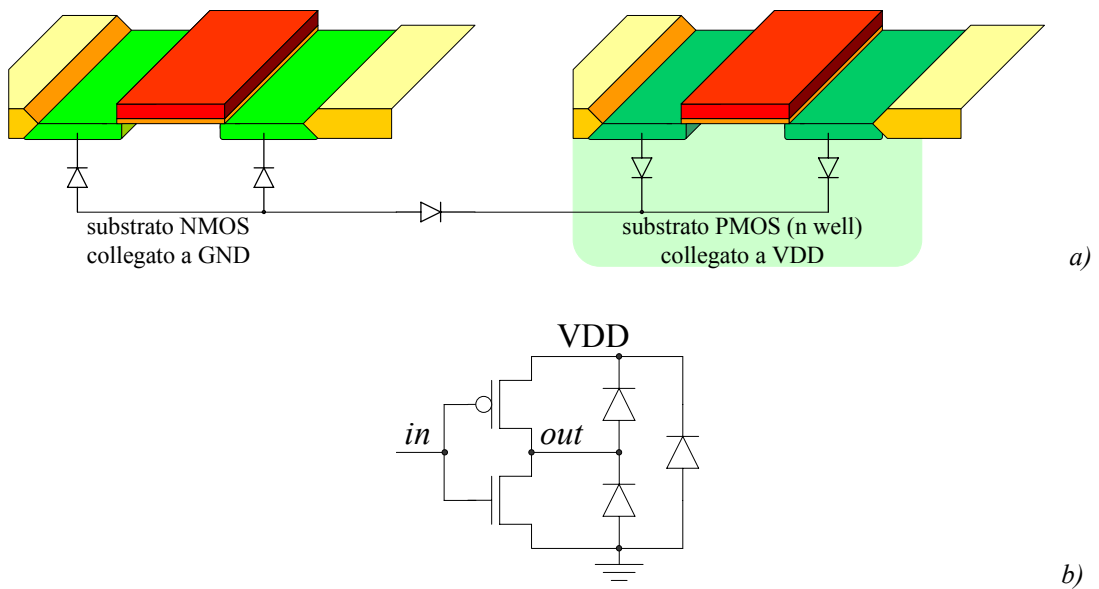


Figura 22. Diodi polarizzati inversamente presenti in una struttura CMOS: a) struttura fisica; b) circuito equivalente.

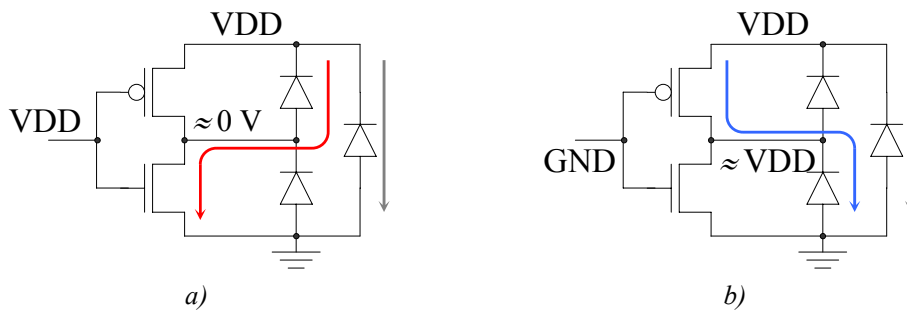


Figura 23. Correnti di leakage; a) pull down acceso; b) pull up acceso.

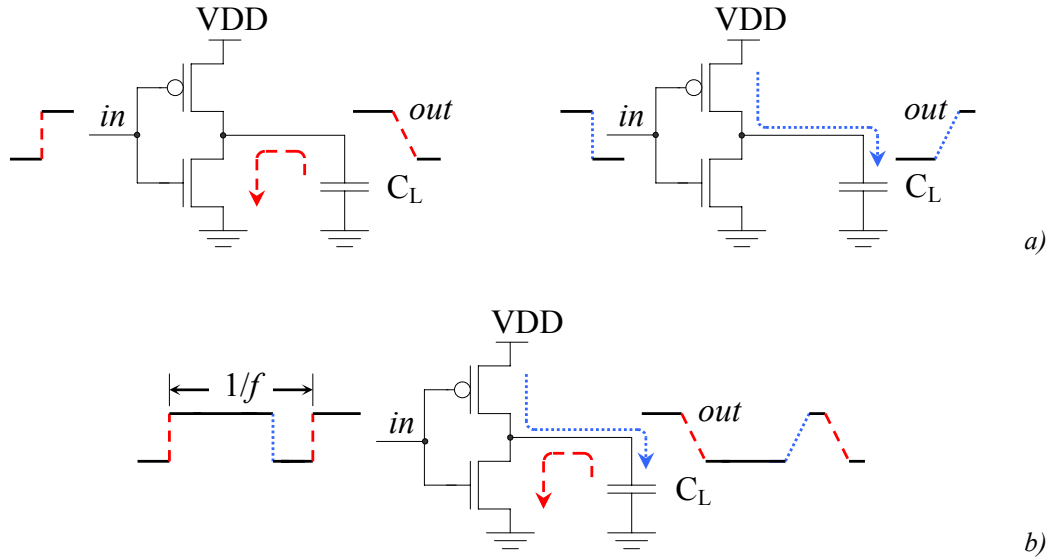


Figura 24. Andamento delle correnti durante la carica e la scarica del condensatore di uscita (le transizioni corrispondenti in ingresso e uscita sono individuate dal tipo differente di tratteggio sulle linee).

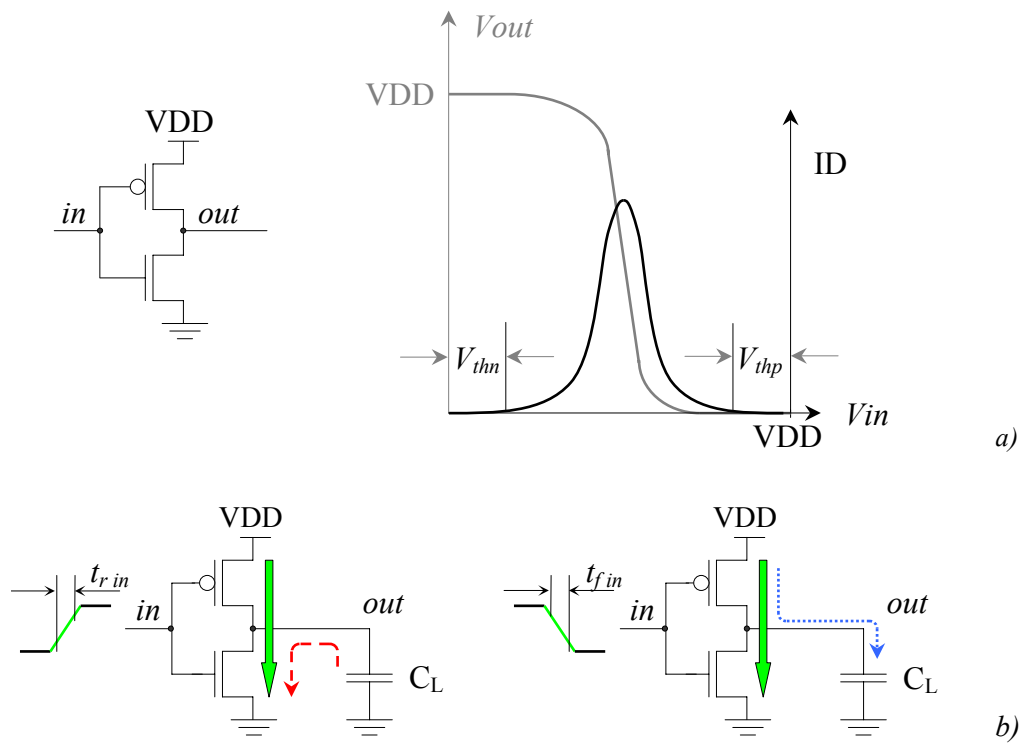


Figura 25. Corrente di corto circuito: a) caratteristica statica di un inverter CMOS e corrispondente corrente di drain statica; b) andamento delle correnti durante la commutazione (in evidenza la corrente di corto circuito, tratteggiate le correnti di scarica e carica del condensatore già descritte al punto precedente).